

日程表(会場別) 1

東海大学 湘南キャンパス

会場名	収容人数	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
A (6号館A)	A1 6A-105	114	11.3 臨界電流, 超伝導パワ-応用		11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長			
	A2 6A-106	114		11.1 基礎物性	11.1 基礎物性		11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用		
	A3 6A-107	114			11.4 アナログ応用および関連技術			11.4 アナログ応用および関連技術		
	A10 6A-115	105	13.7 超薄膜・量子ナノ構造		3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション	3.11 フォトニック構造・現象	3.11 フォトニック構造・現象	3.11 フォトニック構造・現象	3.4 生体・医用光学	3.4 生体・医用光学
	A11 6A-116	105	3.7 レーザープロセス	3.7 レーザープロセス	3.7 レーザープロセス	7.2 電子ビーム応用	3.7 レーザープロセス	3.3 情報フォトニクス・画像工学	3.3 情報フォトニクス・画像工学	3.3 情報フォトニクス・画像工学
	A12 6A-101	105	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン系の理論とデバイス構築	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学		3.1 光学基礎・光学新領域	3.1 光学基礎・光学新領域
	A13 6A-102	105	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	3.2 材料・機器光学	3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション	3.5 レーザー装置・材料	3.5 レーザー装置・材料	
	A14 6A-103	105	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器
	A15 6A-205	114			3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー	3.0 Optics and Photonics English Session	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー
	A16 6A-206	114		3.15 シリコンフォトニクス	3.15 シリコンフォトニクス	3.15 シリコンフォトニクス	7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術		7.4 量子ビーム界面構造計測	
	A17 6A-207	114	3.10 光子量子物理・技術	3.10 光子量子物理・技術	3.13 半導体光デバイス	3.13 半導体光デバイス	13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	15.2 II-VI族結晶および多元系結晶		
	A18 6A-208	114			16.3 シリコン系太陽電池	15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥				
	A19 6A-211	114	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	2.3 放射線応用・発生装置・新技術 2.2 検出器開発		放射線オプティクス	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	2.1 放射線物理一般・検出器基礎 2.2 検出器開発	2.2 検出器開発	
	A20 6A-212	114	9.5 新機能材料・新物性	9.5 新機能材料・新物性	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子			9.3 ナノエレクトロニクス	9.3 ナノエレクトロニクス
	A21 6A-213	114	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	
	A22 6A-214	114			9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換			
	A23 6A-216	105	13.5 デバイス/集積化技術	13.5 デバイス/集積化技術	13.6 Semiconductor English Session	13.5 デバイス/集積化技術	13.5 デバイス/集積化技術	13.5 デバイス/集積化技術		
	A24 6A-217	105				13.7 超薄膜・量子ナノ構造	13.3 絶縁膜技術		13.3 絶縁膜技術	
	A25 6A-218	105	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	13.2 探索的材料物性・基礎物性	13.2 探索的材料物性・基礎物性	13.2 探索的材料物性・基礎物性	13.2 探索的材料物性・基礎物性
	A26 6A-201	105		7.1 X線技術	13.10 化合物太陽電池	13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	13.10 化合物太陽電池		13.10 化合物太陽電池	
A27 6A-202	105	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	8.2 プラズマ診断・計測	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.5 プラズマナノテクノロジー	8.4 プラズマエッチング		
A28 6A-203	105		8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野	16.1 基礎物性・評価	16.1 基礎物性・評価	8.6 プラズマライフサイエンス	8.1 プラズマ生成・制御	8.1 プラズマ生成・制御		
A29 6A-204	105	13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	未来を担う若手科学者の在り方 ~集積化技術の新たな価値創造を目指して~		13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術		
B (6号館B)	B1 6B-101	340	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	15.4 III-V族窒化物結晶	窒化物半導体特異構造の科学 ~成長・プロセスとエレクトロニクス展開~	窒化物半導体特異構造の科学 ~成長・プロセスとエレクトロニクス展開~
	B2 6B-102	340	7.3 微細パターン・微細構造形成技術	7.3 微細パターン・微細構造形成技術		産学協働研究会設立シンポジウム-日本のモノづくり再生に向けた産学官共鳴の創成を目指して-	巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来~北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム~	巨匠が教えてくれた高温超伝導とその未来~北澤宏一先生・前田弘先生追悼シンポジウム~	フォノンエンジニアリング:ナノスケール熱制御のための新しい材料科学, 理論・シミュレーション, 計測技術, およびこれによるデバイス革新	
	B3 6B-103	190		最先端の電子・集束イオンビーム装置技術		宇宙観測・地球観測で活用される光センシング技術	応用物理分野で活躍する女性達-第3回バイオエレクトロニクス編-			
	B4 6B-104	190		フォトニクスと電子情報技術の融合へ向けて	15.6 IV族系化合物	進化するパワー半導体...シリコンからワイドバンドギャップへ	15.6 IV族系化合物	15.6 IV族系化合物	15.6 IV族系化合物	
	B5 6B-105	190		最先端CMOS技術とその将来展望	9.1 誘電材料・誘電体	次世代強誘電体材料の開発指針				
	B6 6B-106	190	化合物薄膜とヘロプスカイト太陽電池融合の可能性	化合物薄膜とヘロプスカイト太陽電池融合の可能性		レーザーによる3次元造形技術の最先端から実用まで	スピントロニクスの将来ビジョン ~スピントロニクスはこれから何をやるのか?~			

日程表(会場別)2

東海大学 湘南キャンパス

会場名	収容人数	3月11日(水)		3月12日(木)		3月13日(金)		3月14日(土)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
C (6号館C)	C1 6C-104	180	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜			7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般
	C2 6C-207	171	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池		16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	太陽電池用ハルック結晶シリコンの成長と評価	
	C3 6C-201	117				リソグラフィ技術の最新動向			
D (16号館D)	D1 16-101	165	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	酸化物半導体における価電子タモルフォロジ		合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス
	D2 16-102	121	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	量子を自在に操る分極反転光デバイス		10.4 半導体・有機・光子スピントロニクス	10.4 半導体・有機・光子スピントロニクス
	D3 16-203	121	12.4 有機EL・トランジスタ	12.4 有機EL・トランジスタ	12.4 有機EL・トランジスタ		12.4 有機EL・トランジスタ		12.4 有機EL・トランジスタ
	D4 16-204	121	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	15.3 III-V族エピタキシャル結晶	15.3 III-V族エピタキシャル結晶
	D5 16-205	121	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	バイオインターフェースの可視化・実用技術の新展開	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー	
	D6 16-206	121	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	17.2 構造制御・プロセス	17.1 成長技術	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ
	D7 16-207	121	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	17.2 構造制御・プロセス	17.1 成長技術	17.3 新機能探索・基礎物性評価		17.4 デバイス応用
	D8 16-303	121	6.4 薄膜新材料	チュートリアル 17.3 新機能探索・基礎物性評価	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.2 構造制御・プロセス
	D9 16-304	121	6.5 表面物理・真空	斜め蒸着法, GLAD, STF等, シャドウイングによるナノ形態の制御と評価	6.6 プローブ顕微鏡	二酸化チタンの最近の動向		6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡
	D10 16-305	121	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	スピントロニクスと相互作用が生み出す酸化物の新しい機能性	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス
	D11 16-306	121	チュートリアル	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)		10.2 スピントルク・スピントロニクス	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	10.5 磁場応用
	D12 16-501	77	1.5 資源・環境	1.7 超音波	1.4 エネルギー変換・貯蔵			1.1 応用物理一般・学際領域	1.6 計測技術・計測標準
	D13 16-502	99		1.3 新技術・複合新領域	15.1 ハルック結晶成長	6.5 表面物理・真空	衝撃および重力場応用の物理の最前線		15.1 ハルック結晶成長
	D14 16-503	286	チュートリアル		8.0 Plasma Electronics English Session 8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 プラズマエレクトロニクス賞授賞式	微粒子合成法とその応用最前線	6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性
	D15 16-504	286	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	クルマ社会の未来を支えるセンシング技術・自動運転システムの展望と課題	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池
E	E1 松前記念館 講堂	490	奨励賞贈呈式	第15回応用物理学会業績賞受賞記念講演 業績賞授賞式 名誉会員贈呈式	なかなかわ発! スマートエネルギー革命			世界一に行きたい科学広場 in 東海大学湘南キャンパス 第二部:科学広場と科学ショー	
F	F1 2N-101	1000						世界一に行きたい科学広場 in 東海大学湘南キャンパス 第一部:シンポジウム	
P (体育館)	P1 P19	ポスターセッション	1.4 エネルギー変換・貯蔵 1.7 超音波 3.11 フォトリソグラフィ・構造・現象 6.2 カーボン系薄膜 7.1 X線技術 17 ナノカーボン	[前半] 10 スピントロニクス・マクネティクス 15.6 IV族系化合物 2.1 放射線物理一般・検出器基礎 2.2 検出器開発 2.3 放射線応用・発生装置・新技術 3.4 生体・医用光学 3.5 レーザー装置・材料 3.10 光子物理・技術 7.2 電子ビーム応用 7.3 微細パターン・微細構造形成技術 11 超伝導 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 13.3 絶縁膜技術 13.5 デバイス/集積化技術	[前半] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 1.5 資源・環境 6.6 プローブ顕微鏡 9.5 新機能材料・新物性 12.2 評価・基礎物性 12.5 有機太陽電池 13.2 探索的材料物性・基礎物性	[後半] 8.1 プラズマ生成・制御 8.3 プラズマ成膜・表面処理 8.6 プラズマライファイエンス 12.4 有機EL・トランジスタ 13.7 超薄膜・量子ナノ構造 15.1 ハルック結晶成長 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.4 III-V族窒化物結晶 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	[後半] 1.6 計測技術・計測標準 3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 材料・機器光学 3.3 情報フォトニクス・画像工学 3.6 超高速・高強度レーザー 3.8 光計測技術・機器 3.14 光制御デバイス・光ファイバ 3.15 シリコンフォトニクス 8.0 Plasma Electronics English Session 8.2 プラズマ診断・計測 8.4 プラズマエッチング 8.5 プラズマナノテクノロジー 12.1 作製・構造制御 13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術 15.3 III-V族エピタキシャル結晶 15.7 エピタキシーの基礎 15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	[後半] 1.2 教育 3.7 レーザープロセス 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 3.13 半導体光デバイス 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 6.5 表面物理・真空 7.4 量子ビーム界面構造計測 7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術 7.6 イオンビーム一般 8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 9.3 ナノエレクトロニクス 9.4 熱電変換 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.8 化合物及びバロニクス 13.9 光物性・発光デバイス 13.10 化合物太陽電池, 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶のコードシェアセッション	・1 講演につき, たて180cm, よこ90cmのバネルが用意されています。予め講演番号, 講演題目, 所属, 氏名を記入した用紙(たて15cm, よこ85cm)を各自が用意し, これをバネル上部に取り付けてください。 ・次にバネルに, 各自が用意したポスター, 図表, 写真などを, 適宜レイアウト(例えば研究目的, 研究方法, 研究成果といった順)にして掲示してください。 ・ポスターの大きさ, 形式は問いませんが, できるだけ見やすく, 大きく書いてください。その際ポスターがバネルにうまく収まるように, 予めポスターの割付けを検討しておくことが便利です。 ・すべての掲示は本部で用意したピンで行ってください。糊の使用はご遠慮ください。